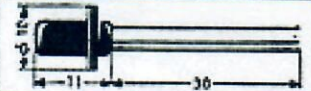
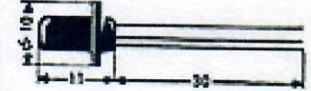



# LES SEMI-CONDUCTEURS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

## TRANSISTORS PNP HAUTE FREQUENCE

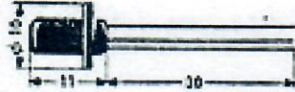
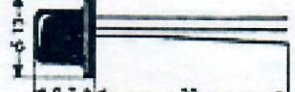
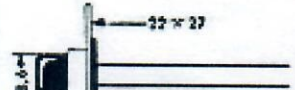
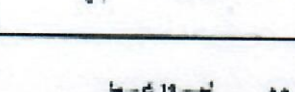

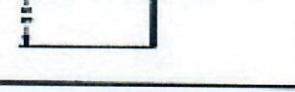

UTILISATION	TYPE	LIMITES ABSOLUES A 25°C			CARACTERISTIQUES A 25°C				DIMENSIONS
		$V_{ce}$ max (Volts)	$I_c$ max (mA)	$P_c$ max (mW)	Gain	$F_r$ (MHz)	$R_{th}$ (°C)	$C_{je}$ (pF)	
Amplificateurs M.F. 455 kHz.	SF-T 106	18	100	150	33 dB (1 mA)	3	85	8	
	SF-T 107	18	100	150	38 dB (1 mA)	7	90	8	
Convertisseur H.F. ....	SF-T 108	18	100	150		13	100	9	
Amplificateur H.F. ....	SF-T 126	24	250	150	35 (1 mA)	5	90	9	
	SF-T 127	24	250	150	40 (1 mA)	7	100	9	
	SF-T 128	24	250	150	70 (1 mA)	14	110	9	

## "DRIFT"

Amplificateur H.F. 10 MHz.	SF-T 115	40	10	150	22 dB	40	30	2	
	SF-T 116	20	10	150	18 dB	30	30	2	
Oscillateur-Mélangeur 23 MHz	SF-T 154	20	10	120	—	100	30	2	
Amplificateur M.F. 455 kHz.	SF-T 119	20	10	150	40 dB (0.6 mA)	30	30	2	
Amplificateur H.F. 30 MHz.	2 N 364	35	10	120	20 dB	100	30	1.8	



# TRANSISTORS PNP BASSE FREQUENCE

UTILISATION	TYPE	LIMITES ABSOLUES A 25°C			CARACTERISTIQUES A 25°C				DIMENSIONS
		V <sub>ce</sub> max (Volts)	I <sub>c</sub> max (mA)	P <sub>c</sub> max (mW)	β <sub>217-β<sub>106</sub></sub>	F <sub>α</sub> (MHz)	R <sub>out</sub> <sup>*</sup> Ω	C <sub>in</sub> <sup>*</sup> (pF)	
Préamplificateurs et drivers...	SF-T 151	24	150	200	30 (1 mA)	1,2	55	32	
	SF-T 152	24	150	200	50 (1 mA)	1,6	60	32	
	SF-T 153	24	150	200	80 (1 mA)	2,4	75	32	
Push - pull C.I.B. jusqu'à 500 mW .....	SF-T 121	24	250	200	30 (100 mA)	1,3	55	32	
	SF-T 122	24	250	200	50 (100 mA)	1,6	60	32	
	SF-T 123	24	250	200	80 (100 mA)	2,6	75	32	
	SF-T 141	45	250	200	30 (100 mA)	1	55	30	
	SF-T 142	45	250	200	50 (100 mA)	1,2	60	30	
Push-pull C.I.B. jusqu'à 2 W.	SF-T 124	24	500	350	30 (250 mA)	1	50	60	
	SF-T 125	24	500	350	70 (250 mA)	2	60	60	
	SF-T 143	45	500	350	30 (250 mA)	1	50	60	
	SF-T 144	45	500	350	50 (250 mA)	1,5	55	60	
Push-pull C.I.B. jusqu'à 2 W.	SF-T 130	24	500	550	30 (250 mA)	1	50	60	
	SF-T 131	24	500	550	30 (250 mA)	2	60	60	
	SF-T 145	45	500	550	30 (250 mA)	1	50	60	
	SF-T 146	45	500	550	50 (250 mA)	1,5	55	60	
Amplificateurs B.F. ....	SF-T 113-213	40	3 A	30 W <sup>90</sup>	40 (2 A)	0,25	—	220	
	SF-T 114-214	60	3 A	30 W <sup>90</sup>	40 (2 A)	0,25	—	220	
	SF-T 150-250	80	3 A	30 W <sup>90</sup>	50 (2 A)	0,25	—	220	
Convertisseurs C.C. ....	SF-T 238	40	6 A	35 W <sup>90</sup>	30 (5 A)	0,30	—	220	
	SF-T 239	60	6 A	35 W <sup>90</sup>	30 (5 A)	0,30	—	220	
	SF-T 240	80	6 A	35 W <sup>90</sup>	30 (5 A)	0,30	—	220	
Convertisseurs C.C. ....	SF-T 265	40	15 A	70 W <sup>90</sup>	20 (12 A)	0,25	—	—	
	SF-T 266	60	15 A	70 W <sup>90</sup>	20 (12 A)	0,25	—	—	
	SF-T 267	80	15 A	70 W <sup>90</sup>	20 (12 A)	0,25	—	—	

\* Température du boîtier  
25°C

90 SF-T 113 - SF-T 114 - SF-T 150 seulement.

NOTA. — Les constructeurs ont établi, pour chaque type de transistor, une fiche technique spéciale très complète, dont nous reproduisons, ci-après, le modèle



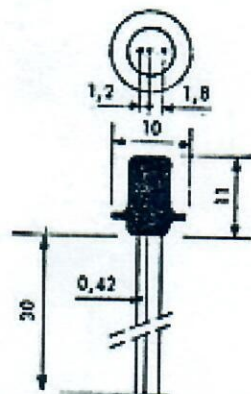
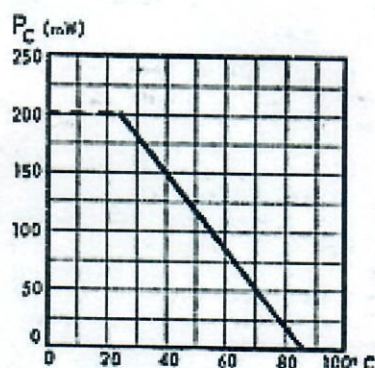
# TRANSISTORS A JONCTION PNP AU GERMANIUM BASSE FRÉQUENCE 200 mW, TYPE SF.T. 121

Destiné à l'amplification des signaux basse fréquence de grande amplitude, il est particulièrement prévu pour les étages de sortie push-pull en classe B jusqu'à 500 mW de sortie environ.

## VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION A 25°C

Tension collecteur-base	$V_{CB}$	- 24	V
Tension émetteur-base	$V_{EB}$	- 12	V
Courant collecteur	$I_C$	- 250	mA
Dissipation à l'air libre pour courbe ci-dessous	$P_C$	200	mW
Température de stockage	$T_{st}$	- 65 + 100	°C

PUISSEANCE DISSIPÉE MAXIMUM  
en fonction de la température ambiante,  
à l'air libre, dans les conditions optima  
d'utilisation.



Le collecteur est repéré par un point de couleur sur la colleterie.

CARACTERISTIQUES GENERALES A 25°C		min.	moy.	max.		
Courant de blocage collecteur	à $V_{CB} = -24$ V	$I_{CBO}$	- 5	- 15	$\mu$ A	
Courant de blocage émetteur	à $V_{EB} = -12$ V	$I_{EBO}$	- 3	- 15	$\mu$ A	
Tension de claquage collecteur-émetteur	$I_B = 0$ $I_C = -0,4$ mA	$BV_{CEO}$	- 20		V	
Tension de perçage	$I_E = 1$ $\mu$ A $R_{BE} = 1$ M $\Omega$	$V_p$	- 24		V	
Gain statique en courant	$I_C = -100$ mA $V_{CE} = -1$ V	$h_{21E}$	20	30	40	
Gain différentiel en courant	$f = 1$ kHz $I_C = -1$ mA $V_{CE} = -6$ V	$h_{21e}$	20	32	55	
Impédance d'entrée		$h_{11e}$	0,6	1,1	1,9	k $\Omega$
Rapport de transfert en Inverse		$h_{12e}$	0,20	0,27	0,40	$10^{-3}$
Admittance de sortie		$h_{22e}$	13	20	34	$\mu$ S
Résistance de base	$I_C = -1$ mA $V_{CE} = -6$ V	$r_{bb'}$		55	$\Omega$	
Fréquence de coupure base à la masse	$I_C = -1$ mA $V_{CB} = -6$ V	$f_{\alpha b}$		1,3	MHz	

NOTA. — Deux transistors ayant le même point de couleur (jaune ou orange) sont appariés en vue de leur utilisation dans les étages push-pull.

SUIVANT DOCUMENTATION  
DE LA  
**COMPAGNIE GÉNÉRALE DE T. S. F.**